

2SD1590

NPNエピタキシャル形シリコントランジスタ (ダーリントン接続)

低周波電力増幅, 低速度スイッチング用

工業用

NPN Silicon Epitaxial Darlington Transistor
Audio Frequency Power Amplifier and Low Speed Switching
Industrial Use

2SD1590は, 低周波電力増幅, 低速度スイッチング用として開発されたモールドパワートランジスタで, OA・FA機器のパルスモータドライバ, プリントドライバ, リレードライバ等にICの出力から直接ドライブする用途に最適です。

特長/FEATURES

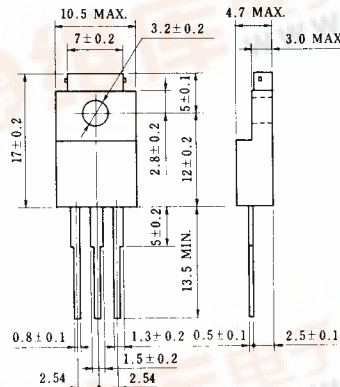
- 絶縁板および絶縁プッシングが不要なモールドパッケージです。
- C-E間逆方向ダイオードを内蔵しています。
- コレクタ飽和電圧が低い。V_{CE(sat)}=1.5 V MAX.(@ 3 A)
- コンプリメンタリトランジスタ: 2SB1099

絶対最大定格/ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T_a=25 °C)

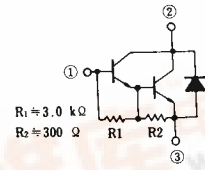
項目	略号	定格	単位
コレクタ・ベース間電圧	V _{CB0}	150	V
コレクタ・エミッタ間電圧	V _{CE0}	100	V
エミッタ・ベース間電圧	V _{EB0}	7.0	V
コレクタ電流(直流)	I _{C(DC)}	+8.0, -5.0	A
コレクタ電流(パルス)	I _{C(pulse)*}	+12, -8.0	A
ベース電流(直流)	I _{B(DC)}	0.8	A
全損失	P _{T(Tc=25°C)}	25	W
全損失	P _{T(Ta=25°C)}	2.0	W
ジャンクション温度	T _J	150	°C
保存温度	T _{stg}	-55 ~ +150	°C

*PW ≤ 10 ms, Duty Cycle ≤ 50 %

外形図/PACKAGE DIMENSIONS (Unit: mm)



電極接続
① Base
② Collector
③ Emitter



2SD1590

電気的特性/ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_a=25 °C)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
コレクタシャ断電流	I _{CB0}	V _{CB} =100 V, I _E =0			1.0	μA
直流電流増幅率	h _{FE1} *	V _{CE} =2.0 V, I _C =3.0 A	2000		15000	
直流電流増幅率	h _{FE2} *	V _{CE} =2.0 V, I _C =5.0 A	500			
コレクタ飽和電圧	V _{CE(sat)} *	I _C =3.0 A, I _B =3.0 mA		0.9	1.5	V
ベース飽和電圧	V _{BE(sat)} *	I _C =3.0 A, I _B =3.0 mA		1.6	2.0	V
ターンオン時間	t _{on}	I _C =3.0 A, I _{B1} =-I _{B2} =3.0 mA		1.0		μs
蓄積時間	t _{stg}	R _L =16.7 Ω, V _{CC} =50 V		3.5		μs
下降時間	t _f	測定回路図参照/See Test Circuit		1.2		μs

*パルス測定 PW≦350 μs, Duty Cycle≦2 %

h_{FE}規格区分

捺印	M	L	K
h _{FE1}	2000~5000	3000~7000	5000~15000

特性曲線/TYPICAL CHARACTERISTICS (T_a=25 °C)

